

รายการอ้างอิง

- [1] Chawanapranee, T. Fabrication and Study on Spectral response of GaAs/GaAlAs Heterojunction Photodiodes. Master Thesis, Department of Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand, 2001
- [2] Wisetlakhorn, P. Fabrication and Study on Spectral response of GaAs/GaAlAs Staircase Band Gap Photodiodes. Master Thesis, Department of Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand, 2003
- [3] Zebda, Y. and Abu-Helweh, S. Bandwidth improvement of a Homojunction p-i-n Photodiode. IEEE Journal of Quantum Electronics. 33, 8 (August 1997): 1333-1337.
- [4] Bhattacharya, P. Semiconductor Optoelectronics Devices. second edition. (n.p.): Prentice-Hall International, 1997.
- [5] Adachi, S. GaAs, AlAs and Al_xGa_{1-x}As: Material parameters for use in research and device applications. Journal of Applied Physics. 58 (August 1985): R1.
- [6] Sugimoto, K., Nakajima, K. and Mizushima, Y. Band-Edge Emphasizing Photodetector Response. IEEE Transactions on Electron Devices. 37, 11 (November 1990): 2298-2302.
- [7] Milnes, A.G. and Feucht, D. L. Heterojunctions and Metal-Semiconductor Junctions. New York: Academic Press, 1972
- [8] Adachi, S. GaAs, AlAs and Al_xGa_{1-x}As: Material parameters for use in research and device applications. Journal of Applied Physics. vol. 58 (August 1985): R1.
- [9] Streetman, B. G. and Banerjee, S. Solid State Electronic Devices. 5th ed. (n.p.): Prentice Hall International, 2000
- [10] Ahrenkiel, R.K., Grubin, H.L., Gupta, R., Hess, K., Patil, M.B., Ravaioli, U., Sakaki, H., Walukiewicz, W. Minority-carrier lifetime and diffusion length in AlGaAs. Properties of Aluminium Gallium Arsenide, Sadao Adachi (ed.), EMIS Datareview Series, The Institution of Electrical Engineers, UK (1993): 221-223.
- [11] บรรยง โดประเสริฐพงศ์. เทคโนโลยีและฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ. ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- [12] อารณ์ ชีรมงคลศรี. เทคโนโลยีของสารประกอบกึ่งตัวนำ. โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีการศึกษา 2533
- [13] ชุมพล อัครเสน, มนตรี สวัสดิ์ศฤงคาร, บรรยง โดประเสริฐพงษ์, ชาราชลปราณี. รายงานการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอุปโตอิเล็กทรอนิกส์. ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [14] Pamplin, B.R. CrystalGrowth. second edition. Pergomon Press. (1980): 421-459.
- [15] Skoog, D., Holler, F., Nieman, T. Principles of Instrumental Analysis. 5th ed. Suanders Collage Publishing, 1998
- [16] Singh, J. Semiconductor Optoelectronics Physics and Technology. International Edition. New York: McGraw-Hill, 1995
- [17] ประภากร สุวรรณะ, สมศักดิ์ ชุมช่วย. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว ดวงพร ฉัตรวีระชัยกิจ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2523 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544-2546



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย